



# 半 导 体 学 报

(BANDAOTI XUEBAO)

第 19 卷 第 1 期 1998 年 1 月

## 目 次

- 异质谷间转移电子器件的 Monte Carlo 模拟研究 ..... 薛舫时 (1)  
MOCVD 生长 MgS 薄膜 ..... 廖清华 范广涵 江风益 熊传兵 彭学新 潘传康 (8)  
ZnSe/ZnCdSe 多量子阱激子光学非线性 .....  
..... 栗红玉 申德振 张吉英 杨宝均 范希武 (12)  
半导体 InP 的高能重离子辐照效应研究 .....  
..... 胡新文 王少阶 陈志权 李世清 侯民东 (16)  
脉冲激光沉积硅基二氧化硅薄膜的蓝光发射 ..... 郑祥钦 郭新立 廖良生 刘治国 (21)  
GaAs/AlGaAs 近表面单量子阱的光调制光谱研究 .....  
..... 刘兴权 陆 卫 徐文兰 穆耀明 陈效双 马朝晖 沈学础 (25)  
梯形截面掩埋结构垂直腔面发射半导体激光器的横模控制 .....  
..... 张宇生 赵一广 陈娓兮 (29)  
单场限环结构击穿电压的表面电荷效应分析 ..... 唐本奇 高玉民 罗晋生 (38)  
InGaAs/InAlAs 多量子阱电吸收光调制器 ..... 王健华 金 峰  
俞 谦 孙 可 李德杰 蔡丽红 黄 纶 周钧铭 王玉田 庄 岩 (43)  
化合物半导体禁带宽度和熔点的人工神经网络预报 .....  
..... 张兆春 彭瑞伍 陈念贻 郭 进 (49)  
功耗和时延双重驱动的 VLSI 布局算法 ..... 孔天明 洪先龙 乔长阁 (54)

## 研究快报

- Structural Investigation of InGaAs/InP Quantum Wire Array Using Triple-Axis  
X-ray Diffractometry ..... Ma Wenquan(马文全), Wang Yutian(王玉田),  
Zhuang Yan(庄 岩), Jiang Desheng(江德生), Zhu Hongliang(朱洪亮),  
Zhang Jingyuan(张静媛), Duan Lihong(段俐宏), Wang Wei(王 坤) (61)  
导纳谱研究锗硅单量子阱的退火效应 .....  
..... 柯 炼 林 峰 张胜坤 谌达宇 陆 眇 王 迅 (66)  
阳极氧化对 GaAs/AlGaAs 量子线荧光的影响 ..... 陈效双  
万明芳 刘兴权 窦红飞 陆 卫 沈学础 S. Yuan, G. Li and C. Jagadish (72)  
选择腐蚀确定垂直腔面发射激光器生长偏差对模式波长的影响  
..... 张 益 潘 钟 杜 云 陈志标 郑联喜 吴荣汉 (76)